

# 半導体デバイス酸化膜の膜厚評価



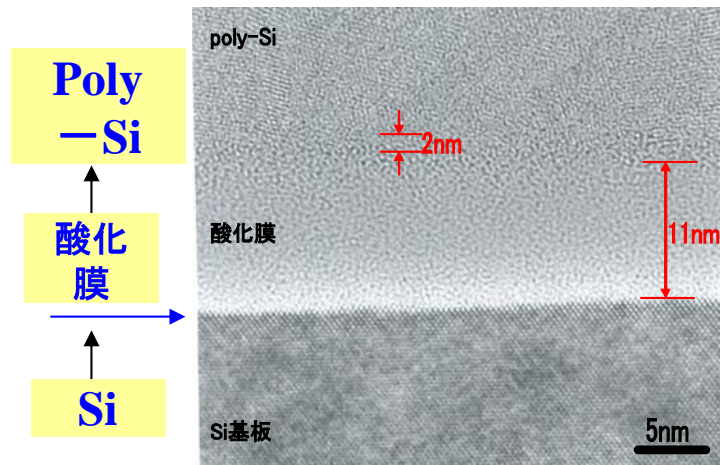
## <分析手法>TEM(透過型電子顕微鏡)

半導体デバイスのミクロン領域に存在するpoly-Si とSi 基板間に成膜した酸化膜の膜厚を調べるため、TEM(透過型電子顕微鏡)を用いて観察しました。

## <結果>

poly-Si 膜と Si 基板間に約11nmの酸化膜(非晶質層)が形成されていることが確認できました。

更に、poly-Si の底面に約2nmの凸凹が存在することも分かりました。



TEM観察結果